

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能, 低温漂, 大功率
陶瓷基板, 50Ω共面波导
金丝键合, 适用于多芯片集成模块

技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.6	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	5.1	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-3.1GHz	dBc
带外抑制	40@4.2-8.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85°C
储存温度	-55 ~ +125°C
外形尺寸	L : 6.5 , W : 6.0 , h : 0.39

外形图：端口居中



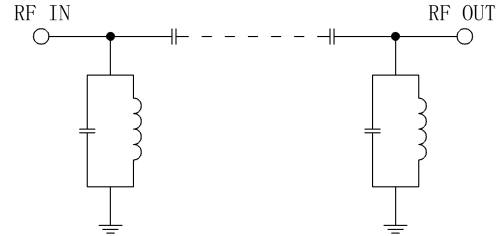
推荐装配图



注意事项

- 1：芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.62mm, 端口可互换;
- 2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
- 3：芯片应安装在可伐 (推荐) 或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C), 载体厚度 ≥ 0.2mm;
- 4：微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线

